数季电路与逻辑设计

Digital circuit and logic design

● 第八章 可编程逻辑器件

主讲教师 何云峰



■提纲





PLD概述



低密度可编程逻辑器件



高密度可编程逻辑器件



■提纲





可编程只读存储器PROM



可编程逻辑阵列PLA



其他低密度可编程逻辑器件





低密度可编程逻辑器件



半导体存储器



随机存取存储器RAM

Random Access Memory

优点:读写方便,使用灵活

缺点:一旦断电,所存储的信息便会丢失,属于易失性存储器





低密度可编程逻辑器件



半导体存储器



只读存储器ROM

Read Only Memory

非易失性存储器,即使切断电源,ROM中的信息也不会丢失

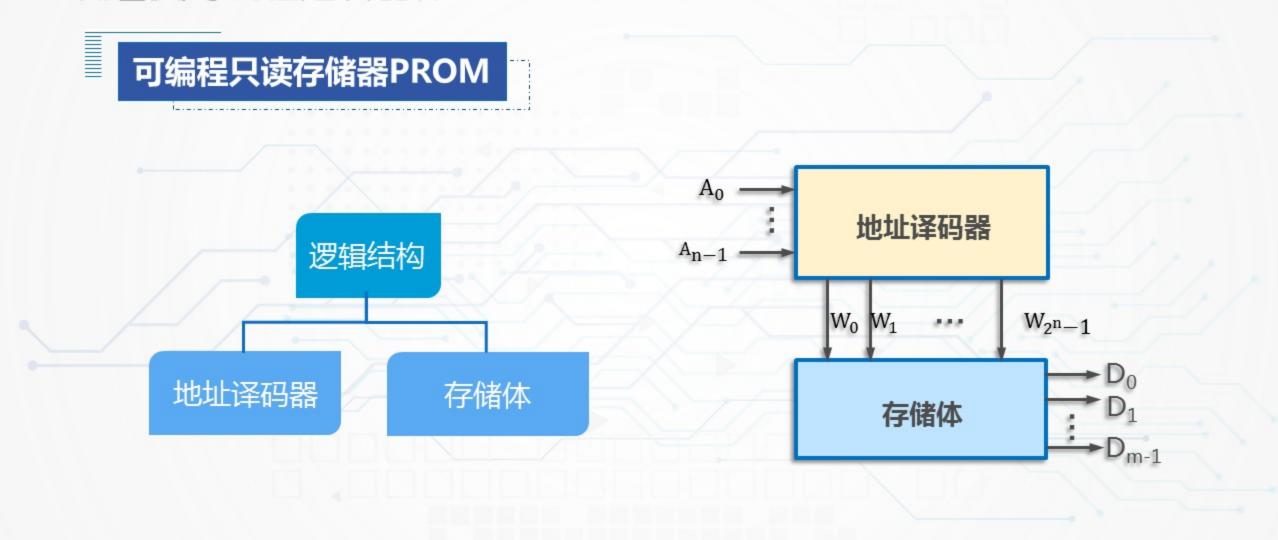
用户可编程ROM(简称PROM)

存放的内容是由用户根据需要在编程设备上写入的

优点:使用灵活方便,适宜于用来实现各种逻辑功能



■低密度可编程逻辑器件





■ 低密度可编程逻辑器件



可编程只读存储器PROM



A₀~A_{n-1} : 地址输入线



 $W_0 \sim W_{2^n-1}$: 地址译码输出线



议 又称为字线



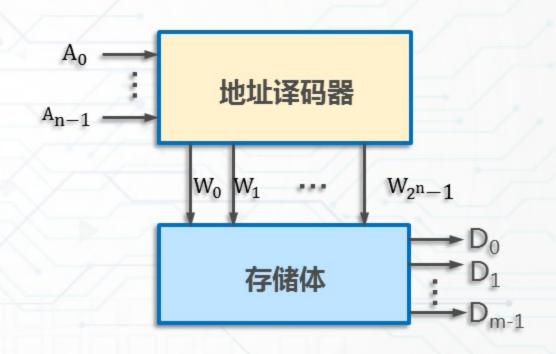
D₀~D_{m-1} : 数据输出线

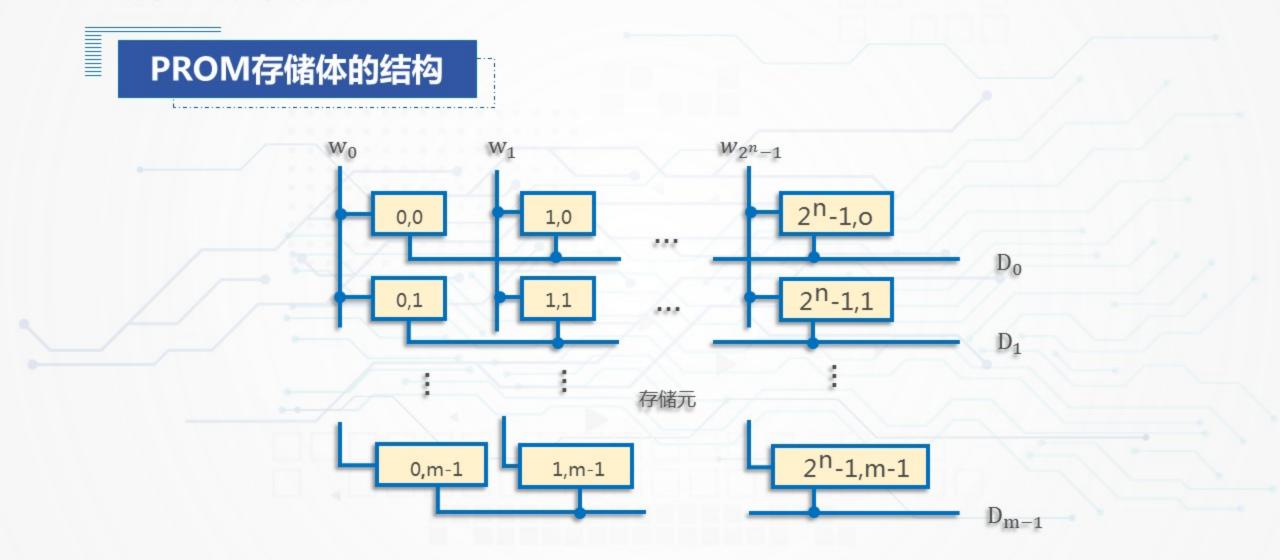


又称为位线



容 量 : 2ⁿ×m(位)











PROM存储体的结构



存储器的角度



PROM由地址译码器和存储体两大部分组成

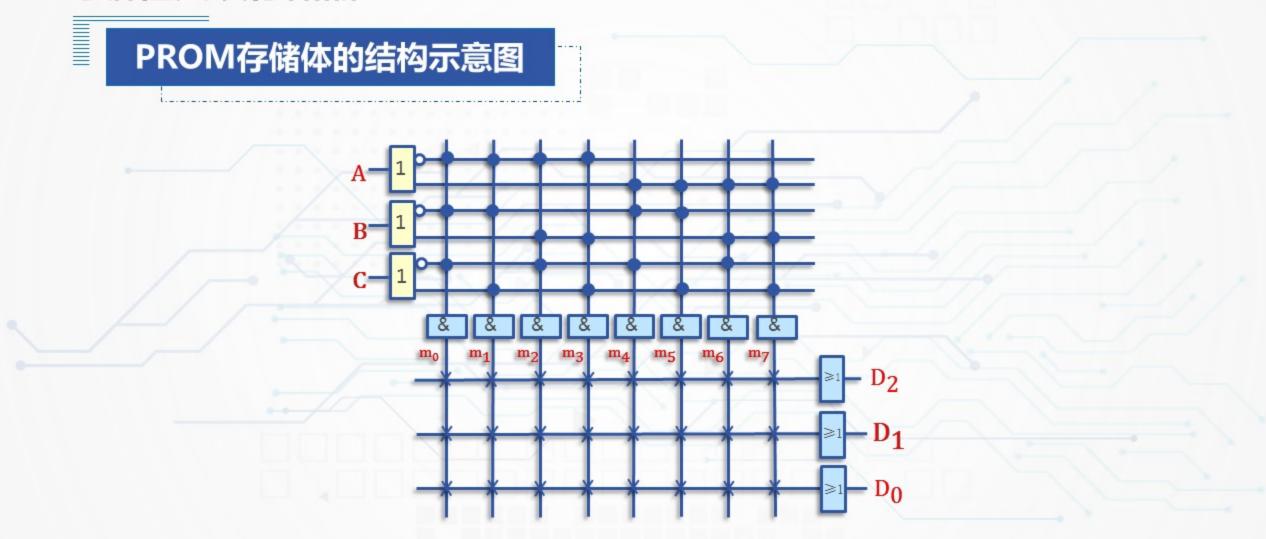


逻辑电路角度



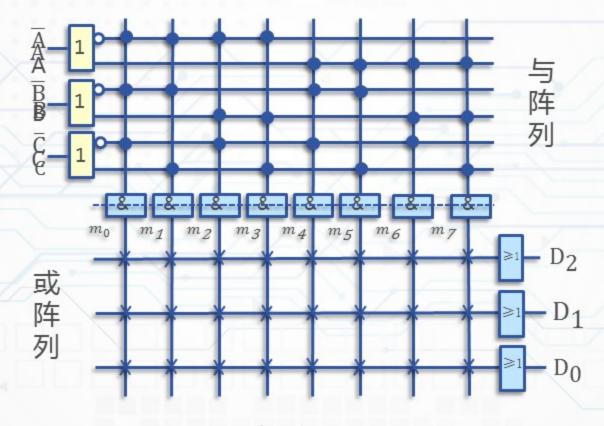
PROM的由一个固定连接的与门阵列和一个可编程连接的或门阵列组成







逻辑结构图的简化



阵列逻辑图







PROM的类型



一次编程的ROM(PROM)

所有存储元均被加工成同一状态 "0" (或 "1"),可通过编程改变某些存储元的状态

泌

编程只能进行一次,一旦编程完毕,其内容便不能再改变

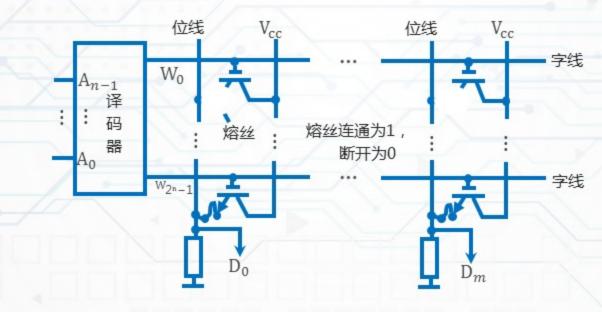




PROM的类型



-次编程的ROM(PROM)



熔丝型PROM结构示意图







PROM的类型



可抹可编程ROM(EPROM)

- EPROM: Erasable Programmable Read Only Memory
- IN EPROM可由用户编程存放指定的信息
- 可通过紫外线照射将原存储内容抹去,再写入新的内容
- 尺能整体擦除、不能以字为单位擦除







PROM的类型



可抹可编程ROM(EPROM)



叠栅注入MOS管的结构示意图、符号和存储元电路







PROM的类型



电可抹可编程ROM(EEPROM或E2PROM)

- EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
- 与EPROM相似,但擦除和编程均用电完成,以字为单位
- 工作电流小、擦除速度快,而且允许改写的次数大大高于EPROM,一般 允许改写1万次以上

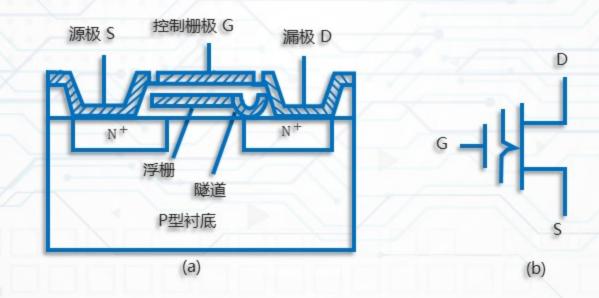








电可抹可编程ROM(EEPROM或E2PROM)



Flotox(浮栅隧道氧化层)MOS管结构示意图和符号







PROM的类型



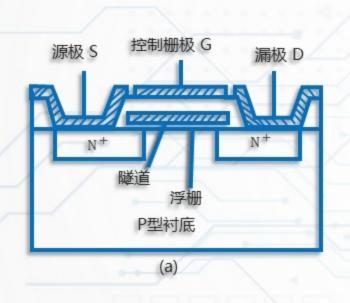
快闪存储器(Flash Memory)

- | 快闪存储器是新一代用电信号擦除的可编程ROM
- 既有EPROM结构简单、编程可靠的优点,又有EEPROM用隧道效应擦除的快速性
- 集成度可以很高,有时归属于高密度可编程逻辑器件





PROM的类型







快闪存储元的结构示意图、符号







PROM的应用



改变"或"阵列上连接点的数量和位置,就可以在输出端形成由输入变量"最小项之和"表示的任何一种逻辑函数



设计过程



根据逻辑要求列出真值表



输出函数表示为最小项之和的形式



根据逻辑函数值对PROM"或"阵列进行编程,画出相应的阵列图





用PROM设计一个代码转换电路,将4位二进制码转换为Gray码。





设4位二进制码为B3B2B1B0



4位Gray码为G₃G₂G₁G₀









真值表

二进制数	Gray码		二进制数	Gray码	
$B_3B_2B_1B_0$	$G_3G_2G_1G_0$	Z	$B_3 B_2 B_1 B_0$	$G_3G_2G_1G_0$	
0000	0000	X	1000	1100	
0001	0001	N	1001	1101	
0010	0011	X	1010	1111	
0011	0010		1011	1110	
0100	0110	-	1100	1010	
0101	0111		1101	1011	
0110	0101		1110	1001	
0111	0100		1111	1000	







输出函数逻辑表达式

$$G0 = \sum m(1,2,5,6,9,10,13,14)$$

$$G1 = \sum m(2,3,4,5,10,11,12,13)$$

$$G2 = \sum m(4,5,6,7,8,9,10,11)$$

G3 =
$$\sum m(8,9,10,11,12,13,14,15)$$



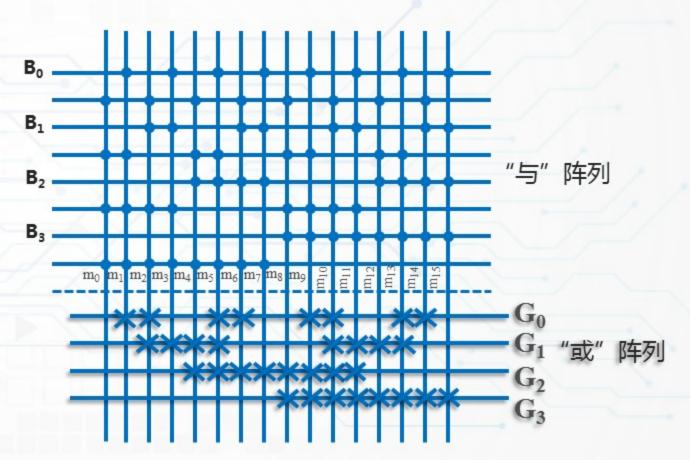
选容量为24×4的PROM

$$G0 = \sum m(1,2,5,6,9,10,13,14)$$

G1 =
$$\sum m(2,3,4,5,10,11,12,13)$$

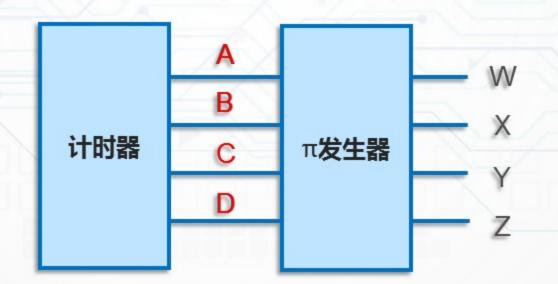
$$G2 = \sum m(4,5,6,7,8,9,10,11)$$

G3 =
$$\sum m(8,9,10,11,12,13,14,15)$$



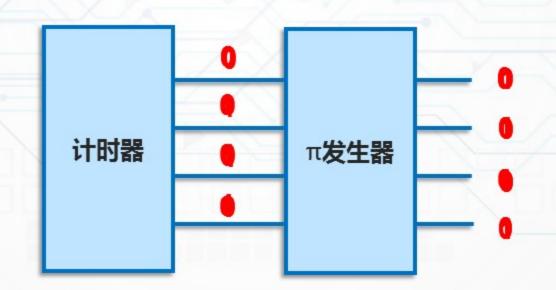
一例2

用PROM设计一个 Π 发生器,输入为4位二进制码,输出为8421码;该电路串行产生常数 π ,取小数点后15位数字,即 π =3.141592653589793。





用PROM设计一个 Π 发生器,输入为4位二进制码,输出为8421码;该电路串行产生常数 π ,取小数点后15位数字,即 π =3.141592653589793。







分 析



4位同步计数器控制PROM的地址输入端,顺序访问所有存储单元



存储单元中依次存放π的值,输出则为π的8421码

输入			输出				П	
A	В	C	D	W	X	Y	Z	
0	0	0	0	0	0	1	1	3
0	0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1	0	0	4
0	0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	1	5
0	1	0	1	1	0	0	1	9
0	1	1	0	0	0	1	0	2
0	1	1	1	0	1	1	0	6

输入			输出				П	
A	В	C	D	1	W X	11		
1	0	0	0	0	1	0	1	5
1	0	0	1	0	0	1	1	3
1	0	1	0	0	1	0	1	5
1	0	1	1	1	0	0	0	8
1	1	0	0	1	0	0	1	9
1	1	0	1	0	1	1	1	7
1	1	1	0	1	0	0	1	9
1	1	1	1	0	0	1	1	3





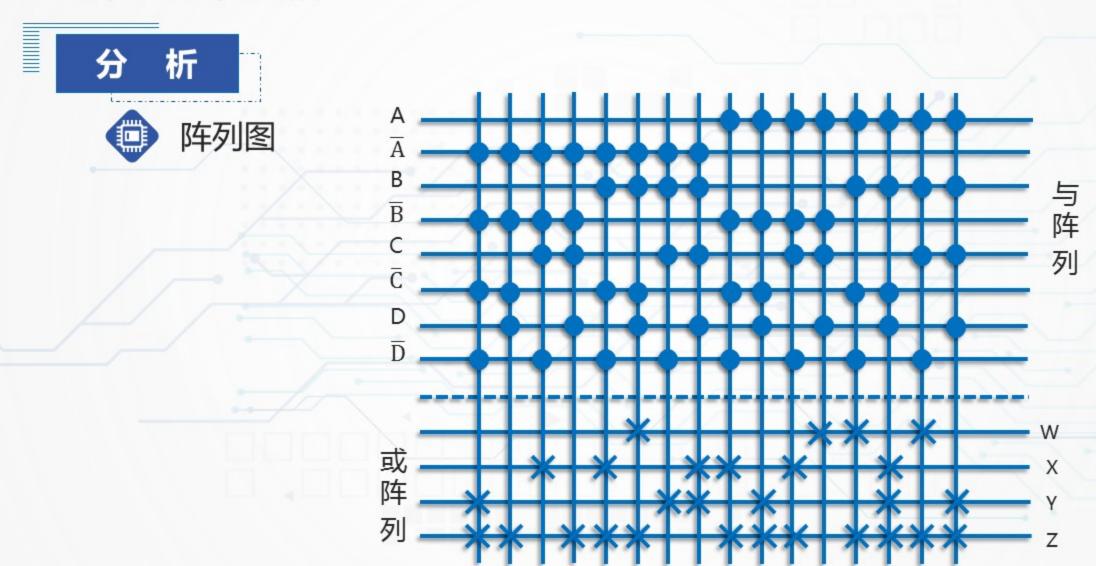
输出函数逻辑表达式

$$W = \sum m(5, 11, 12, 14)$$

$$X = \sum m(2, 4, 7, 8, 10, 13)$$

$$Y = \sum m(0,6,7,9,13,15)$$

$$Z = \sum m(0, 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15)$$





数季电路与逻辑设计

Digital circuit and logic design

● 谢谢,祝学习快乐!

主讲教师 何云峰





逻辑结构图的简化



将PROM中的每个与门和或门都简化成一根线



阵列逻辑图,简称阵列图

